

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07272834 A

(43) Date of publication of application: 20 . 10 . 95

(51) Int. CI

H05B 3/20

(21) Application number: 06061167

(22) Date of filing: 30 . 03 . 94

(71) Applicant:

NGK INSULATORS LTD

(72) Inventor:

ARAI YUSUKE UMEMOTO KOUICHI

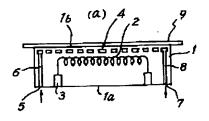
(54) CERAMIC HEATER AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

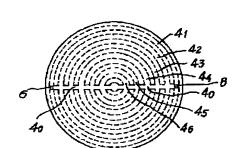
PURPOSE: To provide a high degree of controllability for the temp. distribution of the heating surface of the base of a ceramic heater by forming a fluid passage between the heating surface and a heat emitting resistor, and filling the passage with a fluid.

CONSTITUTION: Current flows in a heat emitting resistor 2 when a ceramic heater is in service, and the heat generated is conducted to the base 1 of the heater. A fluid flows in a certain rate via a fluid inlet 5, flow-in path 6, ring- shaped passages 4₁ -4₅, fluid passage 40, flow-out path 8, and outlet 7. The heat generated by the resistor 2 is conducted through the heater base 1 and is absorbed, convected, and transferred by a fluid flowing in the passage 40 to make uniform the heat distribution in the heater base 1, and the heating surface of the heater gets the temp. uniformly distributed. Because the ring- shaped passages are provided concentrically, the heating surface can have a further uniform temp distribution.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



(6)



庁内整理番号

特開平7-272834

(43)公開日 平成7年(1995)10月20日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H05B 3/20

356

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願平6-61167

(22)出願日

平成6年(1994)3月30日

(71)出願人 000004064

日本碍子株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

(72)発明者 新居 裕介

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

日本碍子株式会社内

(72)発明者 梅本 饒一

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

日本碍子株式会社内

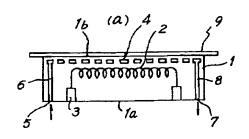
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外5名)

(54)【発明の名称】セラミックスヒータ及びその製造方法

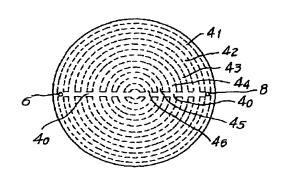
(57)【要約】

【目的】 内部に抵抗発熱体を埋設したセラミックスヒ ータにおいて、ヒータ加熱面を均一に加熱することを可 能とし、また迅速なセラミックスヒータの冷却をするこ とによってセラミックスヒータを用いた真空処理装置等 のダウンタイムを短縮し処理作業性を挙げることを目的 とする。

【構成】 セラミックススヒータ基体1とセラミックス ヒータ基体1に埋設した電気発熱抵抗体2とからなるセ ラミックスヒータにおいて、セラミックスヒータ基体内 部でかつセラミックスヒータ基体の加熱面16と当該発熱 抵抗体2との間に加熱面に沿って延びる流体を充填流し た体流路4が設けられている。



(b)



【特許請求の範囲】

【請求項1】セラミックススヒータ基体とセラミックスヒータ基体に埋設した電気発熱抵抗体とからなるセラミックスヒータにおいて、セラミックスヒータ基体内部でかつセラミックスヒータ基体の加熱面と当該発熱抵抗体との間に加熱面に沿って伸びる流体通路が設けられ、該流体通路内に流体を充填することによって、セラミックスヒータ本体の加熱面の温度の制御を可能としたセラミックスヒータ。

【請求項2】前記流体通路内の流体が強制的にセラミックスヒータ外部から該流体通路に導入され、セラミックスヒータ外部に導出される請求項1記載のセラミックスヒータ。

【請求項3】前記流体がアルゴン、ヘリウム、窒素から 選ばれた不活性ガスである請求項1ないし2記載のセラ ミックスヒータ。

【請求項4】前記セラミックスヒータ基体が円盤状をなし、前記発熱抵抗体がセラミックヒータ基体内で螺旋状に巻回され埋設されている請求項1乃至3のいずれかの 請求項に記載したセラミックスヒータ。

【請求項5】前記流体を $1\sim30$ SCCM の範囲の速度で流す請求項2乃至4のいずれかの請求項に記載したセラミックスヒータ。

【請求項6】前記流体通路がほぼ同心円状に延設された複数の環状の通路からなり、該複数の環状の通路が流体流入口と流体流出口との間に伸びる請求項1万至5のいずれかに記載したセラミックスヒータ。

【請求項7】少なくとも1組の外側流体流入口と外側流体流出口と1組の中央流体流入口と中央流出口とからなり、該1組の外側流体流入口と外側流体流出口との間及び該1組の中央流体流入口と中央流体流出口との間にそれぞれ外周側流体通路と中央流体通路とが周方向に略同心円状でかつジグザグに延びる請求項1乃至5記載のセラミックスヒータ。

【請求項8】前記セラミックスヒータ本体の加熱面部を 周方向に複数の領域に分け、各領域に対応して外周部か ら内周部にかけて周方向にジグザグに延びる通路を設け た請求項1乃至5に記載したセラミックスヒータ。

【請求項9】セラミックススヒータ基体とセラミックススヒータ基体に埋設した発熱抵抗体とからなるセラミックスヒータにおいて、該セラミックスヒータはさらに冷却機構を有し、該冷却機構はセラミックスヒータ基体内内部でかつセラミックスヒータ基体の加熱面と当該発熱抵抗体との間に加熱面に沿って延びる流体通路からなり、 該流体通路内に流体を流すことによってセラミックスヒータの冷却を促進することを可能とした冷却機構付セラミックスヒータ。

【請求項10】前記流体を1 SCCM 以上の速度で流す請求項9記載のセラミックスヒータ。

(請求項11)発熱抵抗体が埋設された第1のセラミッ

【請求項12】第1と第2のセラミックス成形体との接合面の少なくとも一方の接合面に流体通路に対応する形状を与えるマスクを載置し、サンドブラストあるいはエッチング処理によって流体通路を形成する該溝を設け、第1と第2のセラミックス成形体との接合面の少なくとも一方の接合面に対し YSiAION系ガラス等の接着剤を塗む 布後第1のセラミック成形体と第2のセラミック成形体とをガラス塗布層を介して接合させ焼成する請求項11に記載したセラミックスヒータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、各種のPVD、プラズマCVD、減圧CVD、プラズマエッチング、光エッチング装置等の半導体製造装置等に使用できるセラミックスヒータ及びその製造方法に関するものである。

[0002]

40

50

【従来の技術】従来から、緻密質セラミックからなる円盤状のセラミックスヒータ基体内に螺旋状に巻回した発熱抵抗体を埋設し、電気発熱抵抗体の両端に電気端子を接続したセラミックスヒータが知られており、半導体製造装置等用の加熱装置として用いられている。

【0003】セラミックスヒータを用いて、良好な特性を有する半導体装置等を得るためには、該セラミックスピータは、均一な加熱特性を備える必要がある。例えば、半導体製造装置用の加熱装置においては、加熱面における最低温度との差を、加力、加熱面における最低温度との差を、の範囲以内に抑えないという、極めて高い均熱性が要はかのである。である。セラミックス基体内における巻回体の型ではないように設定する必要がある。のはなら、ヒータの加熱面の温度にムラが発生すると、ルカーに加熱することができないからである。となり、半導体不良の原因となってしまうからである。

【0004】上記セラミックスヒータは、一般に以下の

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、実際に円盤状 セラミックスヒータを製造してみると、ヒータの加熱面 の加熱ムラをなくし、温度を均一にすることは、思いの ほかに困難であることが判明した。即ち、抵抗発熱体で ある巻回体は、通常は、細い抵抗線を螺旋コイル形状に 巻いたものであり、非常に容易かつ自由に3次元的に変 形する。従って、巻回体をセラミックス成形体の内部に 設置するときに、巻回体の位置ズレが生じ、また、成形 体の焼成時にはセラミックス粉末が流動するので、この 流動に伴って巻回体が変形する。その結果、隣接する巻 線間距離、セラミックスヒー基体の加熱面から電気抵抗 発熱体までの距離を一定にすることは困難であり、ま た、発熱抵抗体自体が螺旋状に捩ってあるのでヒータ基 体の加熱面から発熱抵抗体までの距離も均一とはいえな い。その結果、ヒータ使用時において、均一な熱分布が 得られず、高度に均一な加熱特性を有するセラミックス ヒータは得られなかった。実際のセラミックスヒータの 製造工程においては、これらの不均一性を生ずる現象お よび同現象を生ずる諸原因についての解決手段はほとん ど解明されていないのが現状であり、上記したような高 度の均熱性を有するセラミックスヒータを定常的に生産 することは困難であった。

【0006】一方、従来、16DRAMの半導体の量産工場では、設備費が増大しつつあり、セラミックスヒータを用いる半導体ウエハー処理装置等には、スループットでウエハーの処理量)の向上と装置のメンテナンスに必らなが要求されている。これでは、装置のダウンタイムとは、該装置をメンテナアでは、装置のダウンタイムとは、該装置をメンテナアでは、ないでは、セラミックスヒータがハンドリング可可には、セラミックスヒータがハンドリングで可能時間と低温での作業時間並びに再度加熱に必要とされる時間を『装置のダウンタイム(休止時間)』といい、このダウンタイムをできるだけ短くすることが要求される。

【0007】特に、熱CVD、エピタキシャル、スパッタ、エッチング装置では、容器内にヒータを設置し、このヒータに半導体ウエハーを設置し、ウエハーを高温に加熱している。しかし、例えばセラミックスヒータを100℃に加熱し、半導体ウエハーを処理した後、抵抗発熱 50

体への電力の供給を停止して基体が80℃以下の温度にまで降温するのには、通常1時間以上の長時間を必要とし、ダウンタイムが長くなっていた。

【0008】従って、特にセラミックスヒータの応答性 を高めるため、セラミックスヒータの温度を自在かつ急 速に変更できるようにし、これによって被処理物質の処 理効率を向上させることが、要求されていた。

[0009]

【発明の解決課題】本発明の課題は、セラミックス製の 10 ヒータ本体と、このヒータ本体の中に埋設された巻回体 である抵抗発熱体とを備えたセラミックスヒータにおい て、加熱面の温度を高度に制御可能なセラミックスヒー タを提供することである。

【0010】さらに、本発明の課題は、セラミックスヒータを迅速に冷却することができるセラミックスヒータを提供することにある。更に、本発明の別の課題は、温度制御性に優れたセラミックスヒータを簡単かつ容易な方法で製造できるセラミックスヒータの製造方法を提供することを目的とする。

20 [0011]

【課題の解決手段】本発明は、セラミックススヒータ基体とセラミックスヒータ基体に埋設した電気発熱抵抗体とからなるセラミックスヒータにおいて、セラミックスヒータ基体内部でかつセラミックスヒータ基体の加熱面と当該発熱抵抗体との間に加熱面に沿って延びる流体通路が設けられ、該流体通路内に流体を充填することによって、セラミックスヒータ本体の加熱面の温度の制御を可能としたセラミックスヒータに関するものである。

【0012】また、本発明は、セラミックススヒータ基体とセラミックスヒータ基体に埋設した電気発熱抵抗体とからなるセラミックスヒータにおいて、該セラミックスヒータはさらに冷却機構を有し、該冷却機構はセラミックスヒータ基体内部でかつセラミックスヒータ基体の加熱面に沿って延びる流体通路からなり、該流体通路内に流体を流すことによってセラミックスヒータの冷却を促進することを可能とした冷却機構付セラミックスヒータに関するものである

【0013】さらに、本発明は、発熱抵抗体が埋設され 40 た第1のセラミックス成形体を形成し、該第1のセラミックス成形体に接合すべき第2のセラミックス成形体及び 形成し、該第1の焼成セラミックス成形体及び 形成し、該第1の焼成セラミックス成形体及び でラミックス成形体とを接合することによってセラミックス スヒータを製造する方法であって、第1と第2のセラミックス成形体との接合面の少なくとも一方の接合 こックス成形体との接合面の少なくとも一方の接合 が体通路を形成する満を設け、第1のセラミックス 形体 体に同通路に連通する流体流入口及び流体流出口を が体に同通路に連通する流体に表望のセラミックス 成形体 と第2のセラミックス 成 形体を接合することによって、該セラミックスレータ基 50 体の加熱面と当該発熱抵抗体との間に該溝と他の接合 とによって加熱面に沿って伸びる流体通路を設けるセラ ミックスヒータの製造方法に関するものである。

[0014]

【作用】本発明のセラミックスヒータによれば、発熱抵抗体で発生した熱は、固体セラミックスヒータ基体中を移動するとともに、一部ガス流路中を流れるガスに吸収され流体中の対流によってセラミックスヒータ基体の各場所の温度差を減少させ、それによって、セラミックスヒータの温度を均一に制御することを可能とする。

【0015】また、半導体等をセラミックスヒータを用いて処理をする場合、所定の高温で処理後、所定の温度まで冷却し、その後、再度処理をするという工程を繰り返す必要があるが、本発明のセラミックスヒータによれば、ガス通路中に所定の流体を流すことによって、セラミックスヒータに比較して、ダウンタイムを大幅に減少することができ、半導体等の処理対象物のスループット(処理量)を向上することができる。

【0016】また、本発明のセラミックスヒータの製造方法によれば、第1あるいは第2の成形体との接合面の少なくとも一方の接合面に流体流路を形成する溝を設け、同流路に連通する流体流入口及び流体流出口を形成し、第1のセラミック成形体と第2のセラミック成形体とを接合することによって、該セラミックスヒータ基体の加熱面と当該電気発熱抵抗体との間に加熱面に沿って伸びるガス流路を簡便に設けることができ、極めて高度の均熱性を有するセラミックスヒータを、定常的に高い歩留りで量産することできる。

【0017】本発明に係るセラミックスヒータの好ましい実施態様として、以下のものが挙げられる。

- (1) 前記流体通路内の流体が強制的にセラミックスヒータ外部から該流体通路に導入され、該流体通路からセラミックスヒータ外部に導出されるようにされたセラミックスヒータ。この場合には、セラミックスヒータ内の熱分布は通路内の流体の対流及び移動によってより一層均一化が図られる。
- (2) 前記流体として、アルゴン、ヘリウム、窒素から選ばれた不活性ガスを用いるセラミックスヒータ。この場合には、セラミックスヒータを構成しているセラミックス材料及び発熱抵抗体に何ら悪影響を与える事なく所望 40 の均熱効果を達成できる。
- (3) 前記セラミックスヒータ基体が円盤状をなし、前記発熱抵抗体がセラミックヒータ基体内で螺旋状に巻回され埋設されているセラミックスヒータ。この場合には、螺旋状に巻回して発熱抵抗体が円盤状のセラミックスヒータ内に均一に配置されることになり、上記流体通路の設置とあいまってより高い均熱効果が得られる。
- (4) 前記流体通路がほぼ同心円状に延設された複数の環状の通路からなり、該複数の環状の通路が流体流入口と 流体流出口との間に伸びるセラミックスヒータ。この場

50

合には、加熱面の個々の環状領域の加熱を独立かつ均一に制御することが可能となり、特に上記(3) のセラミックヒータの場合に有効である。また、全体の加熱面からみても、小さな領域に分割してそれぞれを均一に制御することにより、加熱面全体をより均一に温度制御できる。

- (5) 少なくとも1組の外側流体流入口と外側流体流出口と1組の中央流体流入口と中央流体流出口とからなり、該1組の外側流体流入口と外側流体流出口との間及び該1組の中央流体流入口と中央流体流出口との間にそれぞれ外周側流体通路と中央流体通路とが周方向に略同心円状でかつジグザグに延びるセラミック・ヒータ。この場合にも、加熱面の外周領域と中央領域とを独立かつ均一に加熱することが可能となり、特に上記(3) のセラミックヒータの場合に有効である。
- (6) 前記セラミックスヒータ本体の加熱面部を周方向に複数の領域に分け、各領域に対応して外周部から内周部にかけて周方向にジグザグに延びる流路を設けたセラミックスヒータ。この場合には、加熱面部を周方向に分けた複数の領域の温度を独立かつ均一に制御できる。

【0018】上記セラミックスヒータの製造方法の好ましい実施態様としては、第1と第2のセラミックス 成形 体との接合面の少なくとも一方の接合面に流体通路に対 なって流体通路を形成するのはエッチング処理によって流体通路を形成するるいはエッチング処理によって流体通路を形成する面はけ、第1と第2のセラミックス成形体との接合面に対し YSiAION系ガラス等の接着 剤を塗布後第1のセラミック本体と第2のセラミック 本体とをガラス 塗布層を介して接合させ焼成する。 この方 法によれば、強固に結合したセラミックスヒータを得ることができる。

【0019】以下に、本発明を詳細に説明する。本発明のセラミックスヒータの基材は、緻密質セラミックスによって形成する。好ましくは、窒化珪素、窒化アルミニウム、サイアロン等の窒化物系セラミックスを用いるる。窒化珪素を用いる場合には、耐熱衝撃性の高いセラミックスヒータが得られる。また、窒化アルミニウムを用いる場合には、ハロゲン系腐蝕性ガスに対して、高い耐蝕性を有するセラミックスヒータが得られる。特に、Y.O.と Yh.O.の心なくともどちらか一方を始

る。特に、Y₁O₁と Yb₁O₁の少なくともどちらか一方を焼結助材として含有する窒化ケイ素、Y₁O₁を焼結助材として含有する窒化アルミニウムはセラミックスとして熱伝導率が高いので、加熱面の均熱性を向上させるという観点から、特に好ましい。

【0020】こうした窒化珪素からホットプレス法によって焼結体を製造すると、加圧軸方向の熱伝導率よりも該軸に対し垂直方向の熱伝導率が高くなる。従って、盤状の基体をホットプレス法によって作製した場合には、盤状基体の加熱面と水平方向の熱伝導率が盤状基体の厚さ方向の熱伝導率よりも大きくなり、均熱性を向上させ

20

50

るという観点から好ましい。また窒化アルミニウムはホットプレス法によって焼結体を製造した場合、熱伝導率の異方性は生じないが、常圧焼結品に比べ、強度、熱伝 導率が向上するので、好ましい。

【0021】巻回体を構成する金属としては、特に高温用のセラミックスヒータにおいては、高融点金属が好ましく、とりわけ、タングステン、モリブデン、白金、これらの合金が更に好ましい。巻回体としては、種々の形状を有するものが使用できるが、コイルスプリング形状の巻回体が、入手し易く好ましい。この巻回体は、線体が螺旋形状に巻回されたもので、、巻回体は略円筒形に螺旋状に延びる。しかし、巻回体の螺旋形状は、円形の他、楕円形、四辺形等の形状とすることもできる。

【0022】流体通路は、セラミックスヒータ基体の内 部でかつ基体の加熱面と発熱抵抗体との間に設けられ る、セラミックスヒータの熱分布を均一にし基体加熱面 の加熱状態を均一にし、及び/またはセラミックスヒー 夕を短期間に冷却を可能とする限り、ガス通路の形状・ 配置等には特に限定がない。また、『流体通路が基体の 加熱面に沿って延びる』とは、必ずしも加熱面と平行に のみ延びる場合のみならず、基体の内部でかつ基体の加 熱面と発熱抵抗体との間にあるのであれば多少上下に波 打つ場合も含む。また、『基体の加熱面と発熱抵抗体と の間』とは、流体通路全体が基体の加熱面と発熱抵抗体 の間に位置する場合のみならず、本発明の均熱・冷却効 果が発揮出来る限り、流体通路の1部が基体の加熱面と 反対側の発熱抵抗体の下方に延在している場合も含む。 また、流体通路は連続して設けられていることが好まし いが、『流体通路が連続して設けられ』とは流体通路中 を流体が連続的に流れることが可能となるように設けら れていることを意味するが、部分的に不連続な場合も含 15

【0023】流体を流体通路内に充填しセラミックスと ータの外部から強制的に流体を流体通路内で移動させな い場合には、適当な封止弁等の流体封止構造が採用され る。また、単に流体通路端部を閉止してもよい。このよ うな封止構造自体は、当業者が容易に適宜採用できるも のであるので詳細な説明は省く。

【0024】流体を流体通路内で強制的に流す場合には、ポンプ、弁、流量計、流体流通路等からなる強制流動機構を流体通路接続する。かかる強制流動機構は当業者であれば容易に適宜採用できるものであるので詳細な説明を省く。この場合には、流体を循環する強制循環流動機構とすることが好ましい。

【0025】流体流路に流す流体としては、アルゴン、ヘリウム、窒素等の不活性ガスが好ましく用いられる。 流体の好ましい流量範囲は、流路の形状、配置、流体の 種類等によって適宜決定される。均熱性を高めることを 目的とする場合は、好ましくは流体を1~30 ISCCMの範 囲内で流すことが望ましい。また冷却速度を高めること を目的とする場合は1 SCCM 以上とすることが好ましく、気体の流速は大きくする方が好ましい。流体流路に流す流体は、常温で流路に導入してもよいし、加熱あるいは冷却状態で導入しても良い。また、常圧、加圧、減圧状態の流体も適宜用いることができる。また、かかる流体は循環使用して流体流路に流すこともでき、この場合には、セラミックスヒータのランニングコストを低減できる。

【0026】次に、本発明に係るセラミックスヒータ及 びその製造方法を添付図面に基づいて説明する。図1 (a) 及び図 1 (b) は、それぞれ本発明の第 1 の実施例に 係るセラミックスヒータの縦断面図及び平面図である。 図中、円盤状のセラミックスヒータ基体1には、巻回状 態の発熱抵抗体2が螺旋状に埋設され、発熱抵抗体の両 端部は、基体1の下面1aに埋設した端子3に接続され いる。セラミックスヒータ基体内部でかつ基体1の加熱 面1bと発熱抵抗体2との間には、図1(b) に示される 形状・配置の流体流路4が設けられており、流体流路の 両端部には流体流入口5及び流体流出口7とがそれぞれ 流体流入路6及び流体流出路8とを介して接続されてい る。セラミックスヒータ基体の加熱面1b上には、被処 理上ウェハ9が載置される。流体流路4の形状及び配置 を更に詳しく述べると、流体流路4は全体的に基体加熱 面2bと略平行に延在しており、流体流路4は環状に延 びる同心円状の流路 4 , , 4 , , 4 , , 4 , , 4 , , 2 及び半径 方向に延びる流体流路4。とからなり、流体流入路6及 び流体流出路8とが最外環状流体流路4、に開口すると ともに流体流路4.の両端部が流体流入路6及び流体流 出路8の開口と連通している。環状流路41,41,41,4 ., 4,, 4, はジグザグ状に連続している。

【0027】セラミックスヒータの使用の際には、発熱抵抗体2に電流が流され、抵抗体2からヒータ基体へ熱が発生する。一方、流体が流体流入口5、流入路6を通って環状流路4、~4、及び流体流路40、流出路8、流出の下を通り所定の流量で流される。それによって夕を通り所定の流量で流される。それによって夕基体のセラミックスヒータを伝達するとともに、流体流路を流動する流体中で吸収・対流・移動され、セラミックスヒータの加熱面でより増一化され、セラミックスヒータの加熱面が増一化され、セラミックスヒータの加熱面が増一化され、セラミックスヒータの加熱面が増一にかられているのでより増一なヒータ加熱面の加熱が可能となる。

【0028】第1の実施例では、流体を流体通路に流す場合について説明したが、適当な封止手段を用いることによって流体を流体通路中に流さずに封止充填してヒータを使用することも可能である。この場合でも、熱の吸収・伝達により流体が流路内を対流することによってヒータ加熱面は均一に加熱される。

[0029] 図2(a) 及び図2(b) は、本発明に係る第2の実施例のそれぞれ縦断面図及び平面図である。第1

20

30

の実施例と第2の実施例と異なる点は、第2の実施例では、2組の流体流路4a、4bが設けられ、それぞれの流体流路の両端部には流体流入口51、52及び流体流出口71、7、とがそれぞれ流体流入路61、62及び流体流出路81、82とを介して接続されている。その他の点は、実質的に路第1の実施例と同一である。

【0030】流体流路4a及び4bについて更に説明すれば、流体流路4aは半径方向外側から半径方向内側へと周方向でかつジグザグ状に延び、一方流体流路4bは中央部に設けられ環状に延びるとともに全体として2字形状をなす。流体流路4aと4bは、全体的に基体加熱面と略平行に延在している。なお、第2の実施例では、セラミックスヒータの加熱面で見て半径方向で中央は、外周部の2つの区域に分けたが、3以上の環状区域に分割しそれぞれの区域に連続する流体流路を設けることもできる

【0031】本発明の第2の実施例によれば、第1の実施例と略同一の効果が得られるとともに、流体流路4aと4bとに流す流体の流量、温度、種類等を変えることによってセラミックスヒータの加熱面の中央部と周辺部の温度を独立かつ均一に設定及び/または制御することが可能となる。

【0032】第2の実施例でも、流体を流体通路に流す場合について説明したが、適当な封止手段を用いることによって流体を流体通路中に流さずに封止充填してヒータを使用することも可能であることは第1の実施例と同様である。

【0033】図3は、本発明に係る第3の実施例の横断 面図である。図3において、陰影をつけた部分は流路の 壁部を表す。第3の実施例では、半径方向に延在する4 つの隔壁11a. 11b. 11c, 11dで基体加熱面を周方向に見 て、4つの等しい面積の扇状の区域に分けられ、それぞ れの区域に、図3に示すように、隔壁12a, 12a, 12 a, 12a, 12a, 12a, 12a, 隔壁12b, 12b, 12b, 12b, 12bs, 12b。; 隔壁12c,, 12c,, 12c,, 12c,, 12cs, 12 c, ; 隔壁12d, , 12d, , 12d, , 12d, , 12d, , 12d, の隔壁群 を設け、各隔壁部は隣接する半径方向の隔壁間に延び、 周方向に延びる隔壁は、隣接する半径方向隔壁との間で 交互に二つの隔壁側に開口している。これらの隔壁によ って、環状の流体流路が半径方向外周部から中央部に向 かってジグザグ状に連続して設けられる。第3の実施例 の他の構成については、第1の実施例と略同一である。 【0034】第3の実施例のセラミックスヒータの使用 の際には、発熱抵抗体2に電流が流される一方、流体を 流体流入口、流入路6を通って環状流路13c, 13d に分 岐し、流体は外周部から中央部と周方向ジグザグ状に流 し、中央部に達すると分岐した流体が合流し、再度流体 は流体流路13a、13bに分岐し、中央部から外周部へと周 方向でジグザグ状に流れ、流体流出路に達する。第3の

ぞれの区域に連続して流体流路を形成したが、周方向を 互いに等しい面積あるいは異なる面積の3つの区域ある いは5つ以上の区域に分け、それぞれの区域に周方向か つジグザグ状の連続した流体流路を形成することもでき る。また、第3の実施例では、流体流入路及び流体流出 路をすべての流体流路に共通して設けたが、それぞれの 流路ごとに流体流入路及び流体流出路を設けることもで きるし、いくつかの流路を組として各組ごとに流体流入 路及び流体流出路を設けることもできる。

[0035]第3の実施例では、第1の実施例で得られる効果に加えて、4つの分割区域をそれぞれ均一に加熱できるという効果があるとともに、隔壁が半径方向に延びているので、加熱面の補強がなされセラミックスヒータの機械的強度は大きくなる。

【0036】次に、本発明に係るセラミックスヒータの製造方法を図4(a)から4(d)に示す模式的断面図図明ある製造工程図に沿って説明する。以下、工程順に説明する。まず、図4(a)に示す第1のセラミックスヒーータの形体を作製する。すなわち、高融点金属の線体を巻回体の両端に端子(電極)を接着し、プレスをの下定の平面的パターンに沿み、予備成形体の表面に洗りにセラミックス粉体を仕込み、予備成形体の表面に洗りである。そして、巻回体をこの凹部に収容し、その上に更にセラミックス粉体を充填し、セラミックス粉体を充填し、円盤状成形体を抑力により焼結させる。

【0037】次に、得られた第1のセラミックス成形体に流体流入路5及び流体流出路6を形成する〔図4(b)〕。その後、流体通路を形成するマスクを第1のセラミックスヒータ基体部分の基体加熱面側の面に載置し、サンドプラスト処理あるいはエッチング処理等を行うこ

とによって流体通路を形成する溝部を設ける〔図4(c)

〕。最後に、ガラス(例えば、YSiALON 系ガラス)等の接着剤を介して溝形成面に薄板状の第2のセラミックス成形体を重ね、焼成することによって薄板状体を一体化する [図4(d)]。本製造方法では、第1のセラミックスヒータ成形体の表面に流体通路形成溝を設けたが、薄板状の第2の成形体に流体流路を形成する溝を設けてもよい。各セラミックス成形体は、ホットプレス法で焼結するのが最も好ましいが、常圧焼結してもよく、あるいは常圧で予備焼結させた後にホットアイソスタティックプレス法で焼結させてもよい。

[0038]

【実施例】本発明のセラミックスヒータの均熱効果を調べるため、以下の実験をした。用いたセラミックスヒータは、図3に示す第3の実施例の形状のもので、各部の寸法は以下の通りであった。なお、セラミックスヒータの基体は、窒化珪素を成形・焼成することにによって形成した。

実施例では、周方向を4つの等面積の区域に分割しそれ 50 1)セラミックスヒータ基体直径: 205 ㎜

2) 流体流路 幅:10㎜、深さ:0.3㎜

3)隔壁 幅:28mm、高さ:0.3mm

4) 加熱面から流体流路上面までの距離: 100

図5に示すように、このセラミックスヒータの流体流入口及び流体流出口にそれぞれ流体流入管14及び流体流出管15を活性銀口ウ16によって接合し、8インチのシリコーンウェハをセラミックスヒータの加熱面上にメカニカルクランプ(図示せず)、で機械的に固定した。流路に流す流体はAr流体を予熱せずに常温で用い、所定の流量で流路中を流しセラミックスヒータの均熱性の測定を行った。

11

【0039】測定にあったては、本試験例で作成した各例のセラミックスヒータを真空容器17に密封状態で配置

し、ウェハを基体加熱面との間に所定の間隔をあけて固定・保持し、基体加熱面の温度の平均値が約 850℃となるように抵抗発熱体を発熱させ、加熱面上に保持されたウェハの中央部(ウェハの中心から直径 190mmの内部領域)の異なる30箇所における温度を赤外線放射温度計で測定した。これらの結果を度数分布で表1に示す。なお、均熱性は、(ばらつき温度÷平均温度×100)で計算した値で表した。従来例として、流体流路を設けていない以外は同一のセラミックヒータを用い、また流体流路内にガスを流さず真空引きしたものを参考例とした

[0040]

【表1】

	ヒーター制御温度	A r ガス流量(SCCM)	ウェハー温度(°C)[均熱性(%)]
従来例	850	-	738±30 (4.1)
参考例	850	0*	7 2 5 ± 3 1 (4.3)
実施例	850	0 **	7 4 0 ± 2 4 (3.2)
	850	1	732±8 (1.1)
	850	1 0	731±4 (0.55)
	850	3 0	727±4 (0.55)
	850	5 0	686±4 (0.58)

(注) * 流体流路内は真空引きした。

** 流体流路内に800℃でlataのArガスを充塡した。

30

【0041】上記表から分かるように、流体流路内を真空にした場合、均熱性は±4.3%であったが、Arガスを充填した状態(1 aim)で均熱性は±3.2%まで向上した。さらに、1 SCCMの一定の流量でArガスを流体流路に流したとき、均熱性は 1.1%まで向上した。一方、Arガスの流量を10 SCCM に変えると均熱性0.55%まで向上した。しかし、10 SCCM より大きい流量でArガスを流体流路に流しても均熱性はこれ以上改善しなかった。

[0042]

【0043】本発明のセラミックヒータは、セラミックスとータ基体とセラミックスヒータ基体に埋設した発熱抵抗体とからなる、該セラミックスヒータはさらに冷却機構を有し、該冷却機構はセラミックスヒータ基体内部でかつセラミックスヒータ基体の加熱面と当該発熱抵抗体との間に加熱面に沿って延びる流体通路からなりる。従って該流体通路内に流体を流すことが可能とした。

【0044】さらに、本発明のセラミックヒータの製造スは、発熱抵抗体が埋設された第1のセラミックとは接続では、発熱抵抗体が埋設された第1のセラミックス成形体を形成し、該第1のセラミックス成形体を形成し、該第2のセラミックス成形体を形成し、対策2のセラミックス成形体をできまって、第1と第2のセラミックス成形体では表であって、第1と第2のセラミックの通路を形成にし、第1のセラミックス成形体に対し、第1のセラミックス成形体を接着である。 を設け、第1のセラミックス成形体を接着であるが、第1のセラミックス成形体を対し、第1のセラミックス成形体を対し、対策を対策を対象によって対策を対象によって対策を対象によって対策を対象によって対象を対象によりには対象を対象によりに対象ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1(a) 及び図1(b) は、それぞれ本発明の第 1の実施例に係るセラミックスヒータの縦断面図及び平 面図である。

【図2】図2(a)及び図2(b)は、それぞれ本発明の第2の実施例に係るセラミックスヒータの縦断面図及び平面図である。

【図3】図3は、本発明の第3の実施例に係るセラミックスヒータの横断面図である。

50 【図4】図4(a) から図4(d) は、本発明に係るセラミ

ックスヒータの製造方法を断面図で説明する工程図である。

【図5】図5はセラミックスヒータの均熱性を調べた実験例を説明する図である。

【符号の説明】

1 セラミックスヒータ基体、1b 加熱面、2 発熱 抵抗体、3 端子、4,40,41,42,43,44,45,4 a, 4 b 流体流路、5,51,52流体流入口、6,61,62 流体流入路、7,71,72 流体流出口、8,81,82 流体流出路、9 ウェハ、11a,11b,11c,11d,12a,12b,12c,12d 隔壁、13a,13b,13c,13d 流体流路、14 流体流入管、15 流体流出管、16 活性銀口ウ、17 真空容器

